



#2 0280
Priority
Date 11/14/03
1-10-03

Please type a plus sign (+) inside this box → ☐

PTO/SB/21 (08-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FORM <i>(to be used for all correspondence after initial filing)</i>	Application Number	10/065,738	
	Filing Date	11/14/2002	
	First Named Inventor	Soichiro Okubo	
	Group Art Unit	(to be assigned)	
	Examiner Name	(to be assigned)	
Total Number of Pages in This Submission	64	Attorney Docket Number	39.003-AG

ENCLOSURES (check all that apply)		
<input type="checkbox"/> Fee Transmittal Form	<input type="checkbox"/> Assignment Papers (for an Application)	<input type="checkbox"/> After Allowance Communication to Group
<input type="checkbox"/> Fee Attached	<input type="checkbox"/> Drawing(s)	<input type="checkbox"/> Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences
<input type="checkbox"/> Amendment / Reply	<input type="checkbox"/> Licensing-related Papers	<input type="checkbox"/> Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)
<input type="checkbox"/> After Final	<input type="checkbox"/> Petition	<input type="checkbox"/> Proprietary Information
<input type="checkbox"/> Affidavits/declaration(s)	<input type="checkbox"/> Petition to Convert to a Provisional Application	<input type="checkbox"/> Status Letter
<input type="checkbox"/> Extension of Time Request	<input type="checkbox"/> Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address	<input type="checkbox"/> Other Enclosure(s) (please identify below):
<input type="checkbox"/> Express Abandonment Request	<input type="checkbox"/> Terminal Disclaimer	
<input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement	<input type="checkbox"/> Request for Refund	
<input checked="" type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Document(s)	<input type="checkbox"/> CD, Number of CD(s) _____	
<input type="checkbox"/> Response to Missing Parts/Incomplete Application	Remarks	
<input type="checkbox"/> Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53		

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT	
Firm or Individual name	JUDGE PATENT FIRM
Signature	
Date	November 14, 2002

CERTIFICATE OF MAILING	
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 on this date: <input type="text"/>	
Typed or printed name	<input type="text"/>
Signature	<input type="text"/>
Date	<input type="text"/>

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Soichiro Okubo, et al.
App. No. : 10/065,738
Filed : November 14, 2002
Title : FARADAY ROTATOR, OPTICAL ISOLATOR,
POLARIZER, AND DIAMOND-LIKE CARBON THIN
FILM
Group/Art Unit : (To be assigned)
Examiner : (To be assigned)
Docket No. : 39.003-AG

Honorable Commissioner of Patents
Washington, D.C. 20231

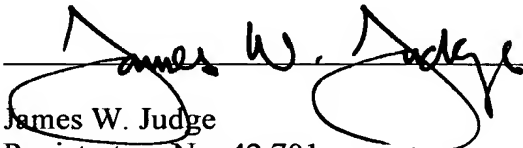
Submission of Documents in Claiming Priority Right
Under 35 U.S.C. § 1.119(b)

Sir:

To complete the claim made for the benefit of earlier foreign filing dates on filing the application identified above, Applicants herewith submit certified copies of **Japanese Patent Application Nos. 2001-387730, filed December 20, 2001; and 2002-082784, filed March 25, 2002.**

Respectfully submitted,

November 14, 2002


James W. Judge
Registration No. 42,701

JUDGE PATENT FIRM
Jamis Bldg. 2nd Fl.
12-5, 3-Chome Isoshi
Takarazuka City
JAPAN 665-0033
Telephone: 1-800-784-6272
Facsimile: 1-425-944-5136



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日
Date of Application:

2001年12月20日

出 願 番 号
Application Number:

特願2001-387730

[ST.10/C]:

[JP2001-387730]

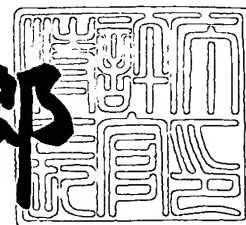
出 願 人
Applicant(s):

住友電気工業株式会社

2002年 9月13日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2002-3071468

【書類名】 特許願

【整理番号】 1011897

【提出日】 平成13年12月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 6/00 316

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式会社 伊丹製作所内

【氏名】 大久保 総一郎

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式会社 伊丹製作所内

【氏名】 松浦 尚

【特許出願人】

【識別番号】 000002130

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

【氏名又は名称】 住友電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100064746

【弁理士】

【氏名又は名称】 深見 久郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100085132

【弁理士】

【氏名又は名称】 森田 俊雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100083703

【弁理士】

【氏名又は名称】 仲村 義平

【選任した代理人】

【識別番号】 100091409

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 英彦

【選任した代理人】

【識別番号】 100099922

【弁理士】

【氏名又は名称】 甲田 一幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008693

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ファラデー回転子、光アイソレータ、および偏光子

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 特定波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させる波長選択性を有したファラデー回転子であって、

磁界方向に進む入射光の偏光面を回転させる磁気光学体と、

少なくとも 1 波長の入射光を前記磁気光学体内に局在させるため、低屈折率層と高屈折率層を交互に積層した誘電体多層膜とを備えた、ファラデー回転子。

【請求項 2】 前記誘電体多層膜は、複数波長の入射光を前記磁気光学体内に局在させることを特徴とする請求項 1 に記載のファラデー回転子。

【請求項 3】 前記磁気光学体は、ガドリニウム鉄ガーネット薄膜から構成されることを特徴とする請求項 1 に記載のファラデー回転子。

【請求項 4】 前記誘電体多層膜は、低屈折率層として酸化シリコン、高屈折率層として酸化チタンを交互に積層することにより構成されることを特徴とする請求項 1 に記載のファラデー回転子。

【請求項 5】 前記磁気光学体および前記誘電体多層膜は、気相プロセスにより一体形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載のファラデー回転子。

【請求項 6】 特定波長の入射光の戻り光のみを選択的に遮断する波長選択性を有した光アイソレータであって、

磁界方向に進む入射光の偏光面を回転させる磁気光学体と、

前記磁気光学体に磁界を印加する磁性体と、

少なくとも 1 波長の入射光を前記磁気光学体内に局在させるため、低屈折率層と高屈折率層を交互に積層した誘電体多層膜と、

入射光から偏光成分を取り出す偏光子と、

前記偏光子と組み合わせて用いられる検光子とを備えた、光アイソレータ。

【請求項 7】 前記誘電体多層膜は、複数波長の入射光を前記磁気光学体内に局在させることを特徴とする請求項 6 に記載の光アイソレータ。

【請求項 8】 前記磁気光学体は、ガドリニウム鉄ガーネット薄膜から構成されることを特徴とする請求項 6 に記載の光アイソレータ。

【請求項 9】 前記磁性体は、室温で強磁性を示し、光に対して透明な窒化ガリウム系磁性半導体薄膜から構成されることを特徴とする請求項 6 に記載の光アイソレータ。

【請求項 10】 前記誘電体多層膜は、低屈折率層として酸化シリコン、高屈折率層として酸化チタンを交互に積層することにより構成されることを特徴とする請求項 6 に記載の光アイソレータ。

【請求項 11】 前記偏光子および前記検光子は、ダイヤモンドライクカーボン薄膜の厚さ方向に対して斜め方向から粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより、屈折率に分布構造をもたせたことを特徴とする請求項 6 に記載の光アイソレータ。

【請求項 12】 前記粒子線はイオンビーム、電子線、陽子線、 α 線、および中性子線のいずれかで、前記エネルギービームは光線、X 線、および γ 線のいずれかであることを特徴とする請求項 11 に記載の光アイソレータ。

【請求項 13】 前記磁気光学体、前記磁性体、前記誘電体多層膜、前記偏光子、および前記検光子は、気相プロセスにより一体形成されていることを特徴とする請求項 6 に記載の光アイソレータ。

【請求項 14】 ダイヤモンドライクカーボン薄膜の厚さ方向に対して斜め方向から粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより、屈折率に分布構造をもたせたことを特徴とする偏光子。

【請求項 15】 前記粒子線はイオンビーム、電子線、陽子線、 α 線、および中性子線のいずれかで、前記エネルギービームは光線、X 線、および γ 線のいずれかであることを特徴とする請求項 14 に記載の偏光子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、ファラデー回転子、光アイソレータ、および偏光子に関し、より特定的には、光通信分野などにおいて、光波の偏光面を回転させるファラデー回転子、光源からの戻り光を遮断する光アイソレータ、および特定の偏光成分のみを透過させる偏光子に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

光ファイバおよび光学素子などから構成される光通信システムでは、光コネクタ接続点や光回路部品等からの反射光が光源に再入射する場合がある。この光源とりわけ半導体レーザへの戻り光により生じる雑音が、光通信システムおよび光デバイスの設計に際して大きな問題となることが多い。

【 0 0 0 3 】

この戻り光を遮断する手段として主に用いられるのが光アイソレータで、構成要素としてファラデー回転子、偏光子、検光子、および磁性体などがある。

【 0 0 0 4 】

ファラデー回転子は、磁気光学体（磁気光学材料）に、磁性体等で磁界を印加することにより磁界方向に進む入射光の偏光面を回転させる。一方、偏光子（検光子）は、特定の偏光成分のみを透過させ、それ以外の偏光成分を遮断する。

【 0 0 0 5 】

図 1 2 に示すように、光アイソレータ 6 は、偏光子 2、ファラデー回転子 3、検光子 4、および磁性体 5 などの組み合わせで構成され、磁気光学材料の非相反特性を利用することにより、入射した光が逆方向から再入射するのを遮断する。以下に、一般的な光アイソレータの仕組みを、図 1 2 を参照しながらより具体的に述べる。

【 0 0 0 6 】

光源 1 からの入射光は、まず偏光子 2 を通ることにより偏光面がそろえられ、次にファラデー回転子 3 を通過することにより偏光面が 4 5 度回転する。偏光面が 4 5 度回転した入射光はそのまま検光子 4 を通って射出され、その一部が戻り光として再び検光子 4 を通ってファラデー回転子 3 に再入射する。戻り光はファラデー回転子 3 により再び偏光面が 4 5 度回転し、偏光面が合計 9 0 度回転した戻り光は偏光子 2 を通過することができず、戻り光はそこで遮断される。

【 0 0 0 7 】

なお、光源 1 からの出射光もしくは戻り光を示す矢印に対してある角度で描かれている矢印は、その出射光もしくは戻り光の偏光方向を模式的に表わしたもの

である。

【0008】

従来のファラデー回転子（磁気光学体）には、イットリウム鉄ガーネット（Yttrium Iron Garnet：以下、YIG）結晶やビスマス置換ガーネット結晶などが主に用いられていた。また従来の偏光子（検光子）には、ルチル（酸化チタン）単結晶や表面に銀粒子を一方向に配向させたガラスなどが、磁気光学体に磁界を印加する磁性体にはサマリウム系の希土類磁性体などが主として用いられていた。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

従来のファラデー回転子に主として用いられていたYIG結晶やビスマス置換ガーネット結晶などは、所要のファラデー回転角を得るのに一定の厚みが必要となるため、外形が大きくなる。同様に、従来の偏光子（検光子）に主として用いられていたルチル単結晶や表面に銀粒子を一方向に配向させたガラス、および磁気光学体に磁界を印加する磁性体として主に用いられていたサマリウム系の希土類磁性体なども、やはり一定の体積を占めるので外形が大きくなる。また、これらのファラデー回転子、偏光子（検光子）および磁性体を基本的な構成要素とする従来の光アイソレータは、とりわけ外形が大きくなるという問題があった。

【0010】

一方、これらのファラデー回転子、偏光子（検光子）および磁性体はそれぞれが高価であり、これらを構成要素とする従来の光アイソレータは一層コストがかかる。さらに、従来の光アイソレータは、個々の構成要素が独立しているためそれらを組み立てる工程が煩雑となり、そのためより一層コストもかかる、という問題があった。

【0011】

また、従来のファラデー回転子は、原則として厚みによりファラデー回転角が決まってしまうため、単一波長にしか対応できない。このため、従来のファラデー回転子を構成要素とする従来の光アイソレータも、やはり基本的には単一波長にしか対応できないという問題があった。

【0012】

以上のことから、この発明の目的は、第1に、ファラデー回転子、偏光子、検光子、磁性体、およびそれらを構成要素とする光アイソレータをそれぞれ小型化しつつコストを抑えること、第2に、複数波長にも対応できるファラデー回転子および光アイソレータを提供することである。

【0013】

【課題を解決するための手段】

この発明は、特定波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させる波長選択性を有したファラデー回転子であって、磁界方向に進む入射光の偏光面を回転させる磁気光学体と、少なくとも1波長の入射光を磁気光学体内に局在させるため、低屈折率層と高屈折率層を交互に積層した誘電体多層膜とを備える。

【0014】

好ましくは、誘電体多層膜は、複数波長の入射光を磁気光学体内に局在させることを特徴とする。

【0015】

より好ましくは、磁気光学体は、ガドリニウム鉄ガーネット薄膜から構成されることを特徴とする。

【0016】

より好ましくは、誘電体多層膜は、低屈折率層として酸化シリコン、高屈折率層として酸化チタンを交互に積層することにより構成されることを特徴とする。

【0017】

より好ましくは、磁気光学体および誘電体多層膜は、気相プロセスにより一体形成されていることを特徴とする。

【0018】

この発明の別の局面によれば、特定波長の入射光の戻り光のみを選択的に遮断する波長選択性を有した光アイソレータであって、磁界方向に進む入射光の偏光面を回転させる磁気光学体と、磁気光学体に磁界を印加する磁性体と、少なくとも1波長の入射光を磁気光学体内に局在させるため、低屈折率層と高屈折率層を交互に積層した誘電体多層膜と、入射光から偏光成分を取り出す偏光子と、偏光

子と組み合わせて用いられる検光子とを備える。

【0019】

好ましくは、誘電体多層膜は、複数波長の入射光を磁気光学体内に局在させることを特徴とする。

【0020】

より好ましくは、磁気光学体は、ガドリニウム鉄ガーネット薄膜から構成されることを特徴とする。

【0021】

より好ましくは、磁性体は、室温で強磁性を示し、光に対して透明な窒化ガリウム系磁性半導体薄膜から構成されることを特徴とする。

【0022】

より好ましくは、誘電体多層膜は、低屈折率層として酸化シリコン、高屈折率層として酸化チタンを交互に積層することにより構成されることを特徴とする。

【0023】

より好ましくは、偏光子および検光子は、ダイヤモンドライクカーボン薄膜の厚さ方向に対して斜め方向から粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより、屈折率に分布構造をもたせたことを特徴とする。

【0024】

より好ましくは、粒子線はイオンビーム、電子線、陽子線、 α 線、および中性子線のいずれかで、エネルギービームは光線、X線、および γ 線のいずれかであることを特徴とする。

【0025】

より好ましくは、磁気光学体、磁性体、誘電体多層膜、偏光子、および検光子は、気相プロセスにより一体形成されていることを特徴とする。

【0026】

この発明の他の局面によれば、偏光子は、ダイヤモンドライクカーボン薄膜の厚さ方向に対して斜め方向から粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより、屈折率に分布構造をもたせたことを特徴とする。

【0027】

好ましくは、粒子線はイオンビーム、電子線、陽子線、 α 線、および中性子線のいずれかで、エネルギービームは光線、X線、および γ 線のいずれかであることを特徴とする。

【0028】

したがって、この発明によれば、ファラデー回転子、偏光子、検光子、磁性体、およびそれらを構成要素とする光アイソレータをそれぞれ小型化し、かつコストを抑えることが可能となる。また、複数波長にも対応できるファラデー回転子および光アイソレータを製造することが可能となる。

【0029】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。

【0030】

[実施の形態1]

図1は、この発明の実施の形態1によるファラデー回転子を模式的に示した図である。

【0031】

このファラデー回転子30は、図1に示すように、磁界方向に進む入射光の偏光面を回転させる磁気光学体30-1と、少なくとも1波長の入射光を磁気光学体内に局在させる誘電体多層膜30-2とを備える。

【0032】

磁気光学体30-1はガドリニウム鉄ガーネット (Gadolinium Iron Garnet: 以下、GIG) 薄膜から構成されており、誘電体多層膜30-2は、低屈折率層として酸化シリコン、高屈折率層として酸化チタンを交互に積層することにより構成されている。

【0033】

図1に示すように、ファラデー回転子30は、磁気光学体30-1の両側に誘電体多層膜30-2を配置して共振構造を作り出すことにより構成されている。この誘電体多層膜30-2の共振構造により、特定波長の入射光を磁気光学体に

局在させることができる。その結果、特定波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させることが可能となる。

【0034】

また、磁気光学体30-1の厚さを調整する、もしくは磁気光学体30-1内に付加的な誘電体層を挟み込むことによって、単一のみならず複数波長の入射光の偏光面を選択的に回転させることが可能となる。さらに、磁気光学体30-1（内部に付加的な誘電体層を挟み込んだ場合はそれも含む）および誘電体多層膜30-2の厚さおよび配置を調整することによって、偏光面を回転させる入射光の波長およびその数を制御することができる。

【0035】

以下に、偏光面を回転させる入射光の波長およびその数が、磁気光学体30-1（内部に付加的な誘電体層を挟み込んだ場合はそれも含む）および誘電体多層膜30-2の厚さおよび配置を調整することによって制御可能なことを、図2から図7のシミュレーション結果によって説明する。

【0036】

図2から図7は、特定波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。図2から図7に示すシミュレーションには、GIG薄膜の代用として酸化タンタル(Ta_2O_5)のデータを、また誘電体多層膜の低屈折率層として酸化シリコン(SiO_2)、高屈折率層として酸化チタン(TiO_2)のデータをそれぞれ使用している。この酸化タンタル、酸化シリコン、および酸化チタンからなる多層膜に波長1000～2000nmの赤外光を入射した際に得られる透過特性をシミュレーションにより計算した。

【0037】

図2は、単一波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【0038】

図2の多層膜構造は、 $1L (1H \ 1L)^5 \ 2M (1L \ 1H)^5 \ 1L$ で表わされる。ここで、Lは酸化シリコンを、Hは酸化チタンを、MはGIG薄

膜の代用としての酸化タンタルをそれぞれ表わす。L, HおよびMの前につく係数は、設計波長1500nmにおける光学膜厚を表わしており、実際の物理膜厚dは、酸化シリコンの屈折率をnとすると、光学膜厚が1Lのとき、

$$d = (1/4n) \lambda$$

で表わされる。また(1H 1L)⁵は、酸化チタンと酸化シリコンの層が各5層、計10層交互に積層されていることを示す。

【0039】

この多層膜構造に波長1000～2000nmの赤外光を入射すると、図2に示すように、波長約1500nmの入射光のみが磁気光学体内で共振し、その近傍およそ1250nm～1850nmまでの波長域の入射光は遮断される。このシミュレーション結果から、図2の多層膜構造からなるファラデー回転子は、単一波長の入射光を磁気光学体内に局在させることにより、単一波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転する作用のあることが確かめられる。

【0040】

図3は、2波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【0041】

図3の多層膜構造は、1L (1H 1L)⁶ 5. 2M (1L 1H)⁶ 1Lで表わされる。多層膜構造を表わす記号の意味は、図2と同様である。

【0042】

この多層膜構造に波長1000～2000nmの赤外光を入射すると、図3に示すように、波長約1380nmおよび波長約1710nmの入射光のみが磁気光学体内で共振し、その近傍およそ1250nm～1850nmまでの波長域の入射光は遮断される。このシミュレーション結果から、図2の多層膜構造において磁気光学体の厚さを変えることにより、2波長の複数入射光を磁気光学体内に局在させられることがわかる。この結果から、図3の多層膜構造からなるファラデー回転子は、2波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転する作用のあることが確かめられる。

【0043】

図4は、図3と同じく2波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【0044】

図4の多層膜構造は、1 L (1 H 1 L)⁶ 2. 2 M 1 L 2 M (1 L 1 H)⁶ 1 Lで表わされる。多層膜構造を表わす記号の意味は、図2と同様である。

【0045】

この多層膜構造に波長1000～2000 nmの赤外光を入射すると、図4に示すように、波長約1410 nmおよび波長約1670 nmの入射光のみが磁気光学体内で共振し、その近傍およそ1250 nm～1850 nmまでの波長域の入射光は遮断される。このシミュレーション結果から、図2の多層膜構造において磁気光学体内に誘電体層を挟み込むことによっても、2波長の複数入射光を磁気光学体内に局在させられることがわかる。この結果から、図4の多層膜構造からなるファラデー回転子は、磁気光学体内に誘電体層を挟み込むことによっても、図3と同じく2波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転する作用のあることが確かめられる。

【0046】

図5は、図3と同じく2波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【0047】

図5の多層膜構造は、1 L (1 H 1 L)⁶ 2. 3 M 1 L 2 M (1 L 1 H)⁶ 1 Lで表わされる。多層膜構造を表わす記号の意味は、図2と同様である。

【0048】

この多層膜構造に波長1000～2000 nmの赤外光を入射すると、図5に示すように、波長約1420 nmおよび波長約1690 nmの入射光のみが磁気光学体内で共振し、その近傍およそ1250 nm～1850 nmまでの波長域の入射光は遮断される。このシミュレーション結果から、図4の多層膜構造において磁気光学体の厚さを調整することにより、磁気光学体内に局在する入射光の2

波長の共振ピーク値を変えられることがわかる。この結果から、図5の多層膜構造からなるファラデー回転子は、磁気光学体の厚さを調整することにより、図4の場合とは異なる2波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転する作用のあることが確かめられる。

【0049】

図6は、図3と同じく2波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【0050】

図6の多層膜構造は、 $1L \quad (1H \quad 1L)^6 \quad 2. \quad 2M \quad 1L \quad 1H \quad 1L \quad 2M \quad (1L \quad 1H)^6 \quad 1L$ で表わされる。多層膜構造を表わす記号の意味は、図2と同様である。

【0051】

この多層膜構造に波長 $1000 \sim 2000 \text{ nm}$ の赤外光を入射すると、図6に示すように、波長約 1450 nm および波長約 1620 nm の入射光のみが磁気光学体内で共振し、その近傍およそ $1250 \text{ nm} \sim 1850 \text{ nm}$ までの波長域の入射光は遮断される。このシミュレーション結果から、図4の多層膜構造において磁気光学体内に挟み込む誘電体層の厚さを調整することによっても、磁気光学体内に局在する入射光の2波長の共振ピーク値を変えられることがわかる。この結果から、図6の多層膜構造からなるファラデー回転子は、磁気光学体内に挟み込む誘電体層の厚さを調整することによっても、図4の場合とは異なる2波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転する作用のあることが確かめられる。

【0052】

図7は、3波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させるファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【0053】

図7の多層膜構造は、 $1L \quad (1H \quad 1L)^6 \quad 2. \quad 2M \quad 4L \quad 2M \quad (1L \quad 1H)^6 \quad 1L$ で表わされる。多層膜構造を表わす記号の意味は、図2と同様である。

【0054】

この多層膜構造に波長1000～2000nmの赤外光を入射すると、図7に示すように、波長約1330nm、波長約1530nm、および波長約1760nmの入射光のみが磁気光学体内で共振し、その近傍およそ1250nm～1850nmまでの波長域の入射光は遮断される。このシミュレーション結果から、図2の多層膜構造において、磁気光学体および磁気光学体内に挟み込む誘電体層の厚さおよび配置等を調整することにより、3波長の複数入射光を磁気光学体内に局在させられることがわかる。この結果から、図7の多層膜構造からなるファラデー回転子は、3波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転する作用のあることが確かめられる。

【0055】

図2から図7のシミュレーション結果から、ファラデー回転子30を用いて偏光面を回転できる入射光の波長およびその数が、磁気光学体30-1（内部に付加的な誘電体層を挟み込んだ場合はそれも含む）および誘電体多層膜30-2の厚さおよび配置を調整することによって制御可能であることがわかる。

【0056】

以上のように、実施の形態1によれば、ファラデー回転子30は、磁気光学体30-1の両側に配置された誘電体多層膜30-2の共振構造により、単一波長のみならず複数波長の入射光を磁気光学体30-2内に局在させることが可能である。

【0057】

また、磁気光学体30-1および誘電体多層膜30-2はともに薄膜構造であって、両者を薄膜積層技術により一体化することも可能である。これにより、磁気光学体30-1、誘電体多層膜30-2、および両者を組み合わせたファラデー回転子30の小型化およびコスト削減が可能となり、さらにファラデー回転子30の製造工程も簡素化できる。

【0058】

[実施の形態2]

図8および図9は、この発明の実施の形態2による光アイソレータを模式的に示した図である。

【 0 0 5 9 】

図 8 の光アイソレータ 6 0 a は、実施の形態 1 に示したファラデー回転子 3 0 の両側に偏光子 2 0 および検光子 4 0 を配置し、さらに磁性体 5 を上下から配置した構造となっている。

【 0 0 6 0 】

実施の形態 1 において説明したように、ファラデー回転子 3 0 は特定波長の入射光の偏光面のみを選択的に回転させる機能を有する。このため、ファラデー回転子 3 0 を組み込んだ光アイソレータ 6 0 a は、特定波長の入射光の戻り光のみを選択的に遮断することが可能となる。

【 0 0 6 1 】

偏光子 2 0 および検光子 4 0 はダイヤモンドライクカーボン (Diamond Like Carbon: 以下、DLC) 薄膜に斜めから粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより構成することも可能である。なお、この DLC 薄膜により構成された偏光子 (検光子) については、実施の形態 3 において詳述する。

【 0 0 6 2 】

以上により、ファラデー回転子 3 0 が薄膜構造なのに加えて、偏光子 2 0 および検光子 4 0 も薄膜構造とすることが可能なので、これらを薄膜積層技術により一体化することで、光アイソレータ 6 0 a の小型化およびコスト削減が可能となり、また製造工程も簡素化できる。

【 0 0 6 3 】

図 9 の光アイソレータ 6 0 b は、磁性体 5 0 として室温で強磁性を示す窒化ガリウム系磁性半導体薄膜を用いている。図 9 に示すように、光アイソレータ 6 0 b は、この磁性体 5 0 を偏光子 2 0 および検光子 4 0 の外側に配置した構造となっている。

【 0 0 6 4 】

窒化ガリウム系磁性半導体薄膜は光に対して透明であるため、入射光の光路中に配置することが可能である。

【 0 0 6 5 】

このため、偏光子 2 0、ファラデー回転子 3 0、検光子 4 0 に加えて磁性体 5

0 を、図 9 に示すように一直線上に配置することが可能となる。したがって、薄膜積層技術によってこれらを一体化することにより、光アイソレータ 6 0 b は光アイソレータ 6 0 a に比べてさらなる小型化およびコスト削減が可能となり、また製造工程もより一層簡素化できる。

【0 0 6 6】

[実施の形態 3]

図 1 0 は、この発明の実施の形態 3 による偏光子の作製過程を模式的に示した図である。

【0 0 6 7】

この偏光子は、DLC 薄膜 1 1 に斜めから粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより形成されることを特徴とする。粒子線はイオンビーム、電子線、陽子線、 α 線、および中性子線、エネルギービームは光線、X 線、および γ 線などが考えられるが、ここではイオンビームを照射する場合を例にとり、DLC 薄膜に屈折率分布をつける方法を図 1 0 を参照して説明する。

【0 0 6 8】

図 1 0 に示すように、まず DLC 薄膜 1 1 の上に屈折率分布のパターンを転写したマスク 1 2 を密着させる。そのマスク 1 2 の上から、たとえばヘリウムまたはアルゴン等のイオンビームで斜方照射を行なう。マスク 1 2 の透過部分を通してイオンビームの照射を受けた部分は、1 1 - 1 のように屈折率が変わる。一方、マスク 1 2 の遮断部分によってイオンビームの照射をさえぎられた部分は、1 1 - 2 のように屈折率は変化しない。このことから、マスクのパターンを変化させることにより DLC 薄膜 1 1 の屈折率分布を制御することができる。この結果を利用して、DLC 薄膜 1 1 に偏光分離特性をもたせることが可能となる。

【0 0 6 9】

なお、水素を含む DLC 薄膜にイオン照射を行なうことによりその屈折率を 2.0 から 2.5 程度の範囲内で変え得ることは、Diamond and Related Materials 誌の 1998 年度第 7 号 432 頁から 434 頁に報告されている。また、イオン照射などの粒子線照射またはエネルギービーム照射などにより屈折率を変化させることは、水素を含む DLC 薄膜に限らずたとえば窒素などを含む DLC 薄膜

においても可能であり、それらを含まないDLC薄膜においても可能である。

【0070】

ここで、水素を含むDLC薄膜にイオン照射を行なうことによりその屈折率を2.0から2.5程度の範囲内で変え得るという報告を参考に、DLC薄膜を用いた偏光子の性能をシミュレーションした。シミュレーションは、高屈折率層（屈折率2.5）を1層152.5nm、低屈折率層（屈折率2.0）を1層190.63nmとして、各25層、計50層を交互に積層したDLC薄膜に、65度の入射角で波長1000nm～2000nmの赤外光を入射するという設定で行なった。そのシミュレーション結果を図示したのが図11である。

【0071】

図11より、1300nmにおいて偏光消光比が約-35dBに達していることがわかる。この結果から、DLC薄膜に斜めからイオン照射などの粒子線照射またはエネルギービーム照射などを行なうことによって、偏光子（検光子）を作製することが可能であることが確かめられる。

【0072】

次に、DLC薄膜の作製条件について述べる。

水素を含有したDLC薄膜の成膜方法としては、熱、プラズマ等を利用した各種CVD (Chemical Vapor Deposition) 法、スパッタリング法、EB (Electron Beam) 法、アークイオンプレーティング法（フィルタードアーク法）などが存在する。しかしながら、水素を膜中に大量に導入できること、および膜厚が20μm程度は必要となることから、高速成膜が期待できるCVD法が実際上は最適と考えられる。ここでは、平行平板式プラズマCVD法での成膜を取り上げる。

【0073】

平行平板式プラズマCVD法での成膜条件の一例として、基板サイズを30センチ角とし、成膜基板温度を摂氏200度、圧力を $1.3 \times 10^{-1} \sim 1.3 \times 10^{-1}$ Pa、原料ガスであるメタンの流量を100sccmとして、約1000Wの電力で13.56MHzの高周波を印加する。真空槽はロータリーポンプと油拡散ポンプとオリフィスにて圧力制御する。

【0074】

上記の作製条件で作製した DLC 薄膜に、斜めから粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより、DLC 薄膜の屈折率を変化させることができる。この屈折率変化を制御することにより、DLC 薄膜を偏光子として利用することが可能となる。

【0075】

以上のように、実施の形態 3 によれば、DLC 薄膜に斜めから粒子線とエネルギービームのいずれかを照射することにより、薄型で他の薄膜光学素子との積層一体構造にも適した偏光子を作製することができる。

【0076】

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

【0077】

【発明の効果】

以上のように、この発明によれば、ファラデー回転子、偏光子、検光子、磁性体、およびそれらを構成要素とする光アイソレータをそれぞれ小型化し、かつコストを抑えることが可能となる。また、複数波長にも対応できるファラデー回転子および光アイソレータを製造することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 この発明の実施の形態 1 によるファラデー回転子を模式的に示した図である。

【図 2】 単一波長対応ファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【図 3】 2 波長対応ファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【図 4】 2 波長対応ファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【図 5】 2 波長対応ファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表

わした図である。

【図 6】 2 波長対応ファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【図 7】 3 波長対応ファラデー回転子の機能をシミュレーションにより表わした図である。

【図 8】 この発明の実施の形態 2 による光アイソレータを模式的に示した図である。

【図 9】 この発明の実施の形態 2 による光アイソレータを模式的に示した図である。

【図 1 0】 この発明の実施の形態 3 による偏光子の作製過程を模式的に示した図である。

【図 1 1】 D L C 薄膜を用いた偏光子の性能をシミュレーションにより表わした図である。

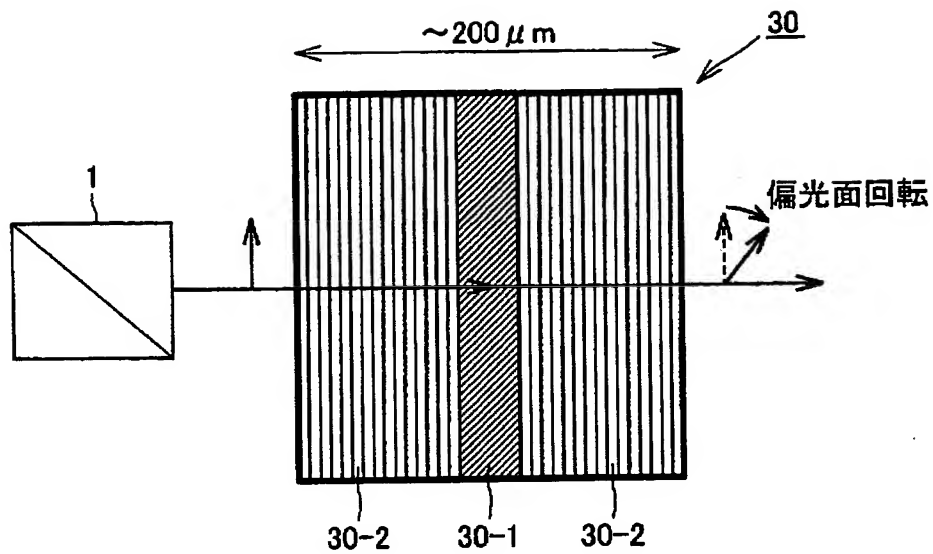
【図 1 2】 一般的な光アイソレータの仕組みを模式的に示した図である。

【符号の説明】

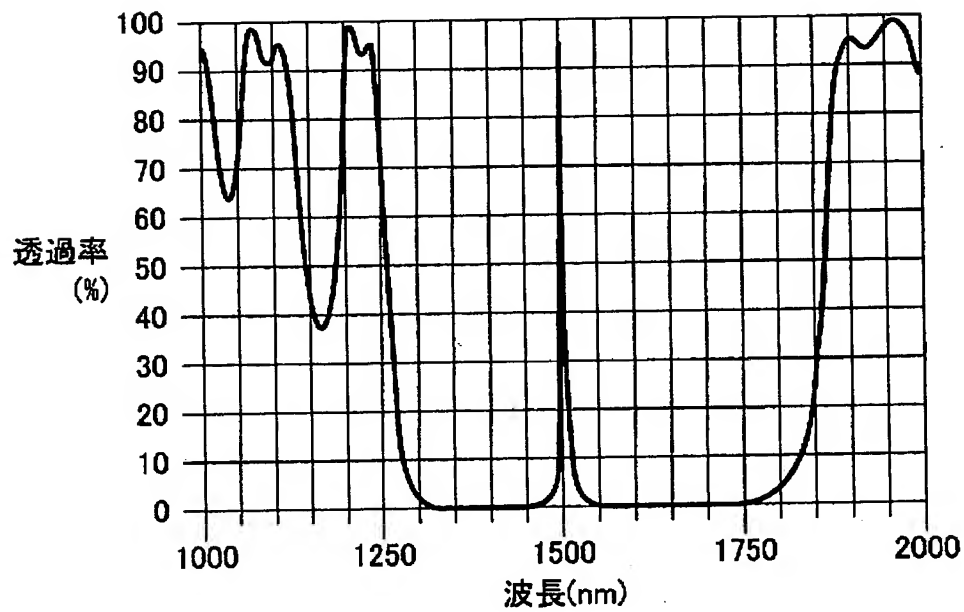
1 光源、2, 2 0 偏光子、3, 3 0 ファラデー回転子、3 0 - 1 磁気光学体、3 0 - 2 誘電体多層膜、4, 4 0 検光子、5, 5 0 磁性体、6, 6 0 a, 6 0 b 光アイソレータ、1 1 D L C 薄膜、1 1 - 1 屈折率変化が生じた部分、1 1 - 2 屈折率変化が生じていない部分、1 2 マスク。

【書類名】 図面

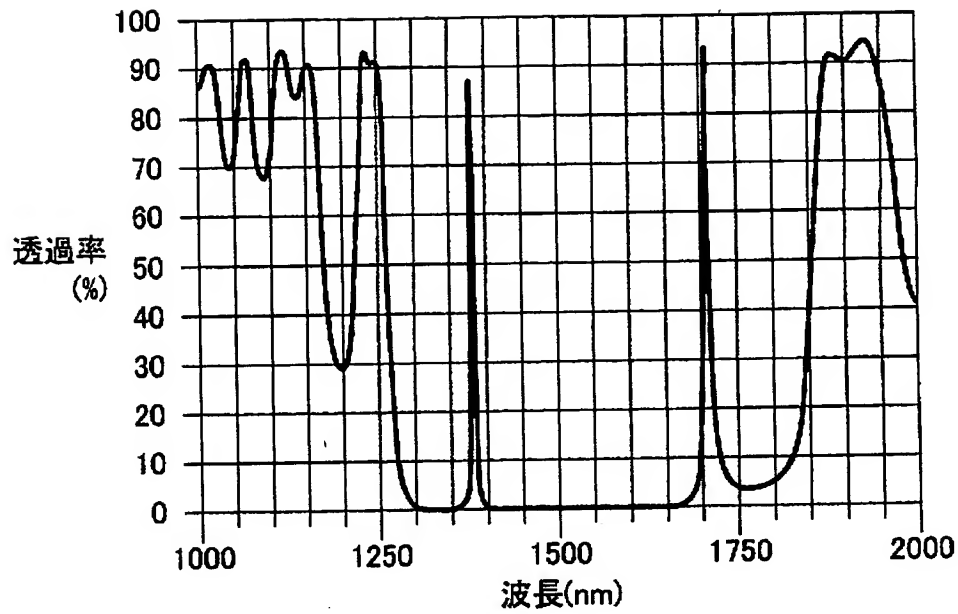
【図 1】



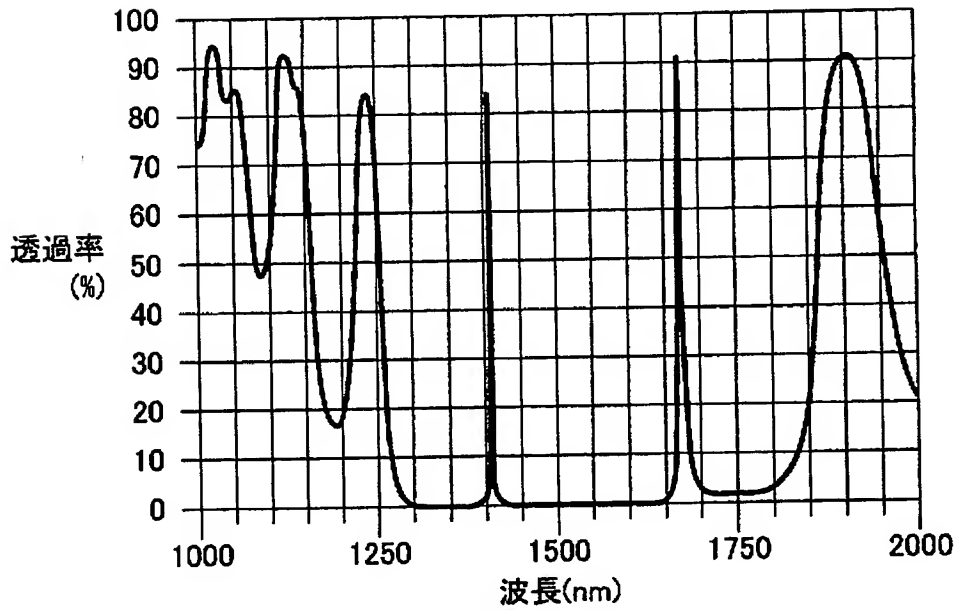
【図 2】



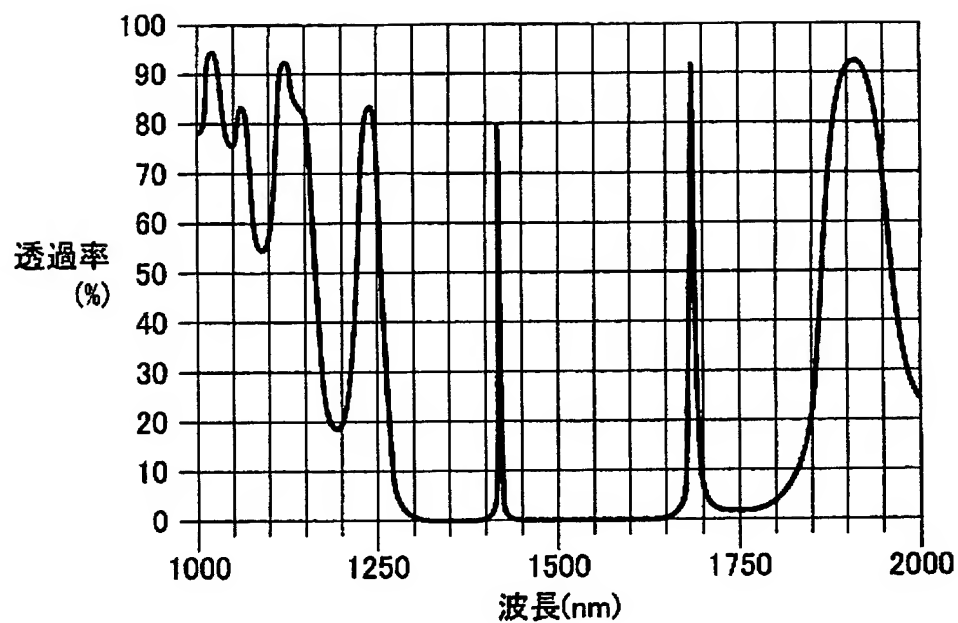
【図 3】



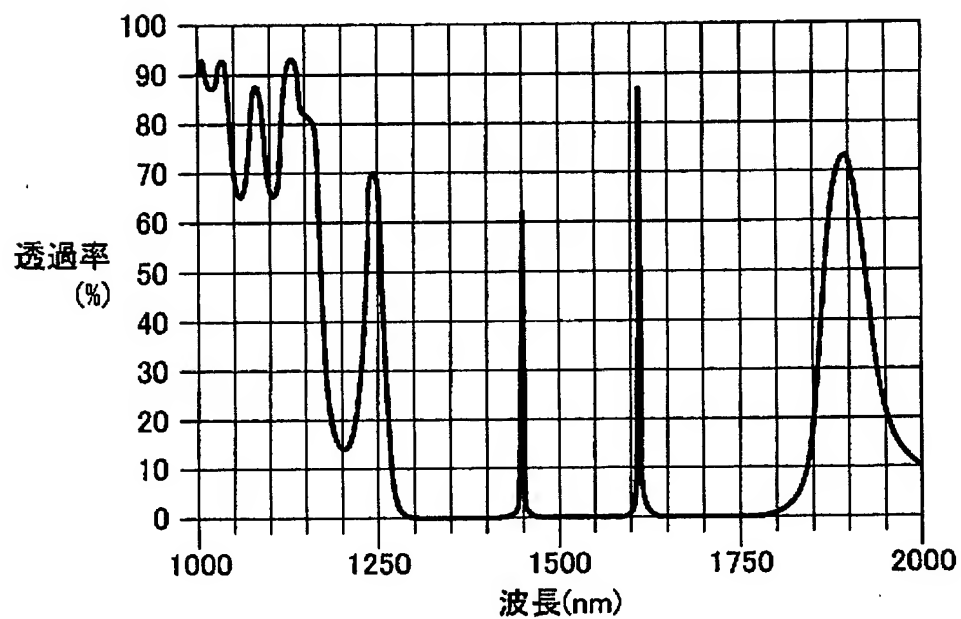
【図 4】



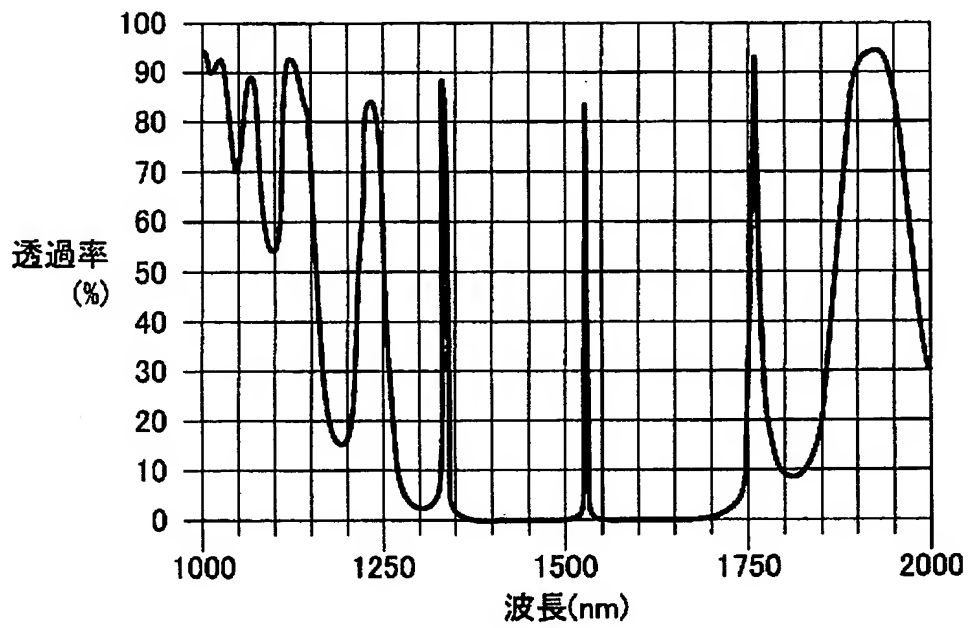
【図 5】



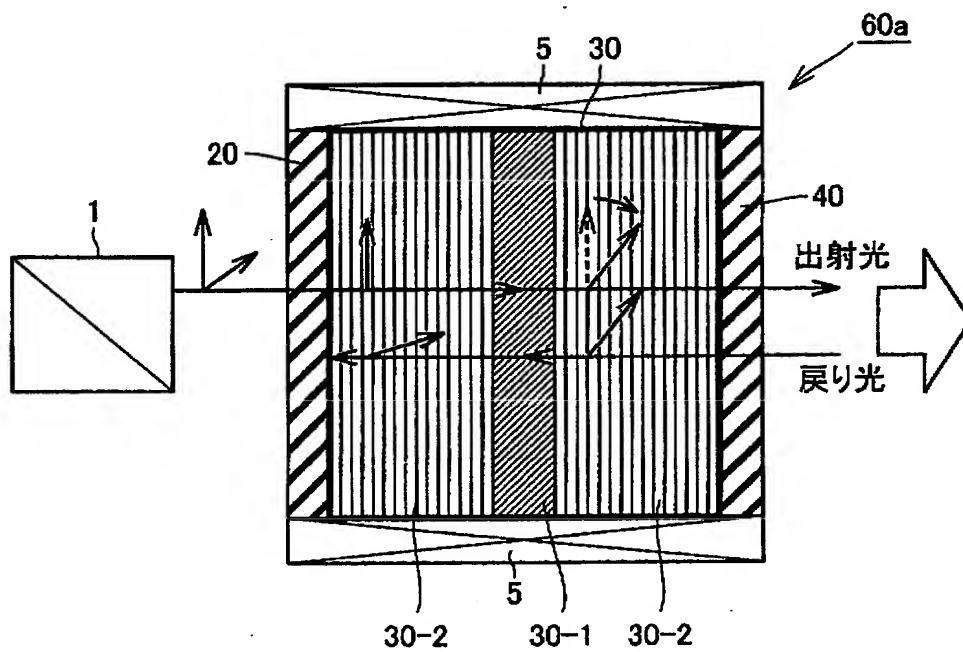
【図 6】



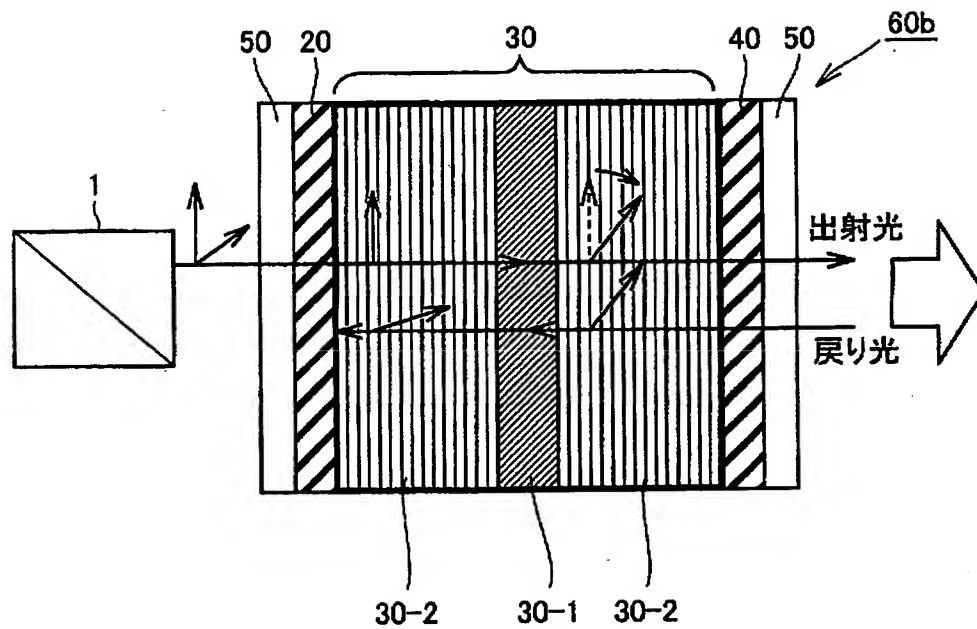
【図 7】



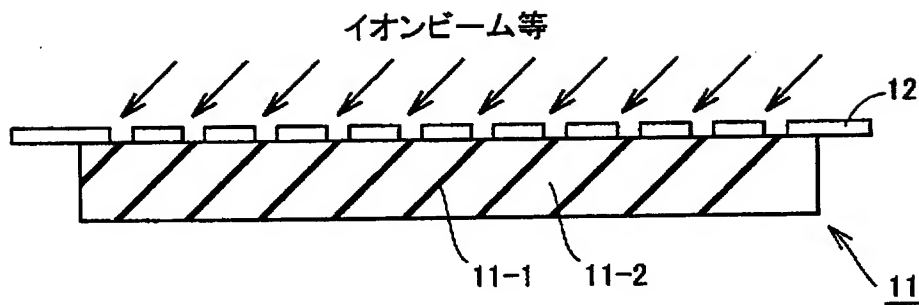
【図 8】



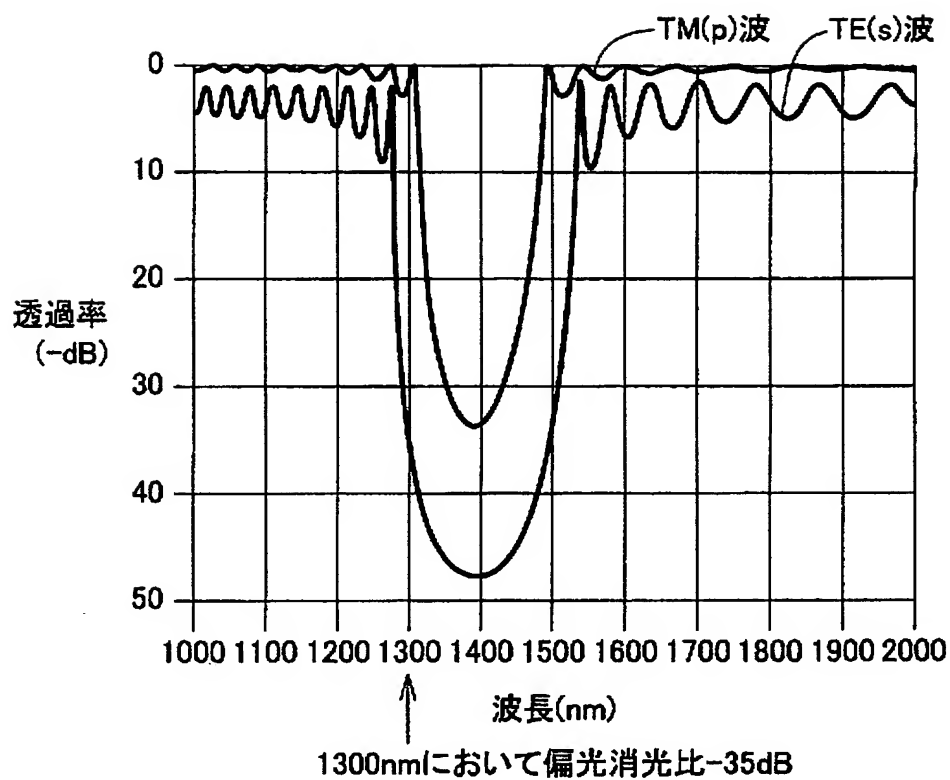
【図 9】



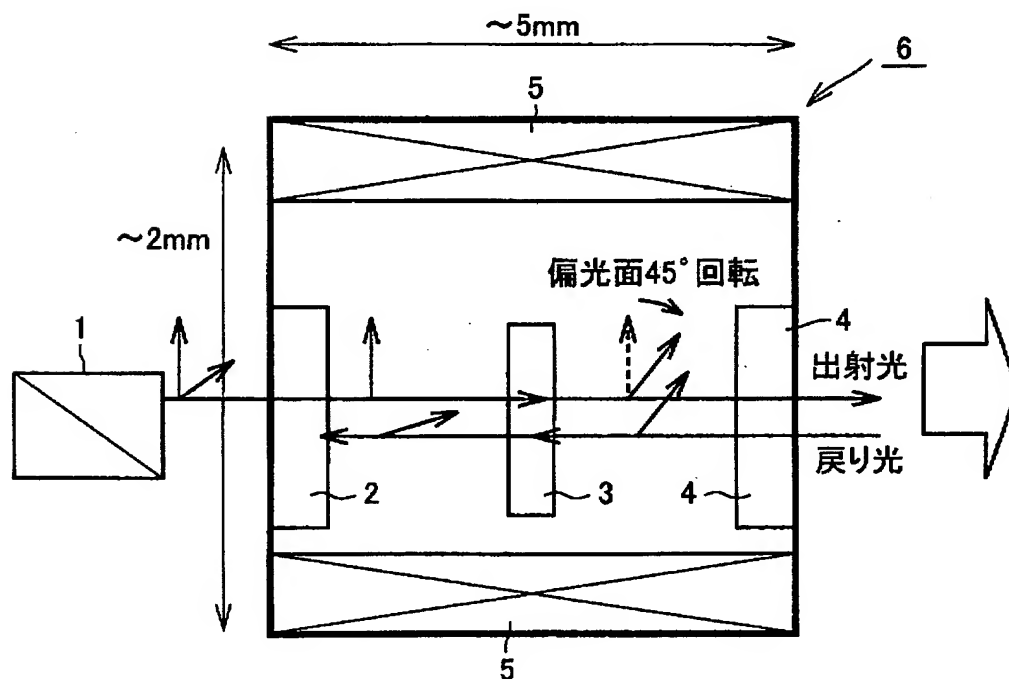
【図 10】



【図 1 1】



【図 1 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 小型で低コストなファラデー回転子、偏光子（検光子）、磁性体ならびに光アイソレータ、および複数波長にも対応できるファラデー回転子ならびに光アイソレータを提供する。

【解決手段】 光アイソレータ 6 0 b は一例として、波長選択性を有したファラデー回転子 3 0 と、D L C 薄膜により形成された偏光子 2 0 および検光子 4 0 と、光に対して透明な磁性体 5 0 とを一直線上に配置することにより構成される。これらを薄膜積層技術によって一体形成することにより製造過程が簡素化され、小型で低コストな光アイソレータを製造することができる。

【選択図】 図 9

出願人履歴情報

識別番号

[000002130]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

氏 名

住友電気工業株式会社